

FKBL400 - FKBL410

PRV : 50 - 1000 Volts
Io : 2.0 Amperes

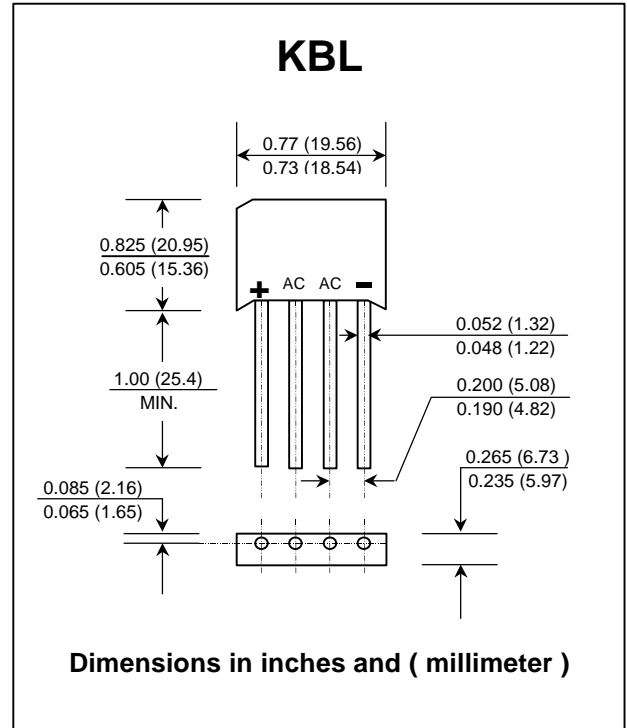
FEATURES :

- * High case dielectric strength of 2000 V_{DC}
- * High surge current capability
- * High reliability
- * Low reverse current
- * Low forward voltage drop
- * Fast switching for high efficiency
- * Ideal for printed circuit board
- * **Pb / RoHS Free**

MECHANICAL DATA :

- * Case : Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique
- * Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
- * Lead : Axial lead solderable per MIL - STD 202 , Method 208 guaranteed
- * Polarity : Polarity symbols marked on case
- * Mounting position : Any
- * Weight : 5.15 grams

FAST RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%.

RATING	SYMBOL	FKBL 400	FKBL 401	FKBL 402	FKBL 404	FKBL 406	FKBL 408	FKBL 410	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current T _c = 50 °C	I _{F(AV)}	4.0							A
Peak Forward Surge Current Single half sine wave Superimposed on rated load (JEDEC Method)	I _{FSM}	150							A
Rating for fusing (t < 8.3 ms.)	I ² t	166							A ² S
Maximum Forward Voltage drop per Diode at I _F = 4.0 A	V _F	1.4							V
Maximum DC Reverse Current T _a = 25 °C at Rated DC Blocking Voltage T _a = 100 °C	I _R	10							μA
	I _{R(H)}	1.0							mA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	T _{rr}	150			250		500		ns
Typical Thermal Resistance per Diode (Note 2)	R _{θJC}	3.3							°C/W
Operating Junction Temperature Range	T _J	- 50 to + 150							°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	- 50 to + 150							°C

Notes :

- 1) Measured with I_F = 0.5 Amp., I_R = 1 Amp., I_{rr} = 0.25 Amp.
- 2) Thermal resistance from Junction to case with mounted on a 2.0" X 1.6"x 0.3" (5 cm. x 4 cm. x 0.8cm) Al. Plate.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FKBL400 - FKBL410)

FIG.1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM

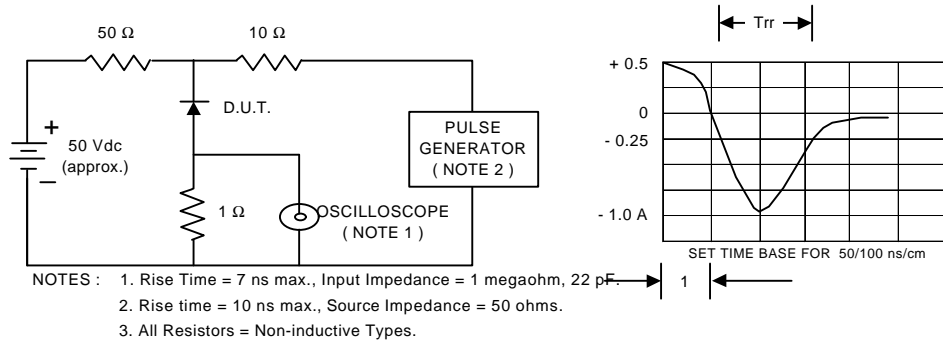


FIG.2 - DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

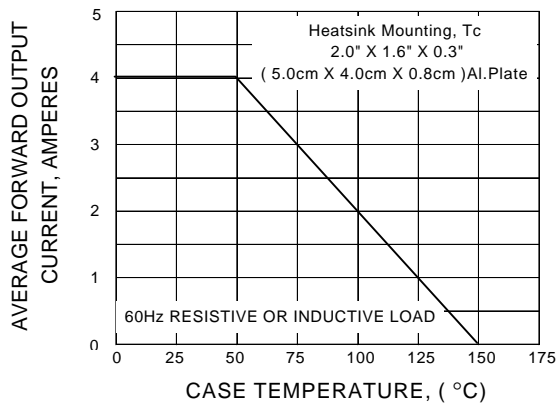


FIG.3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

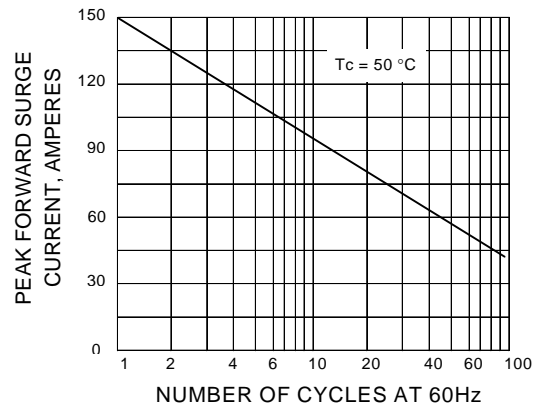


FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER DIODE

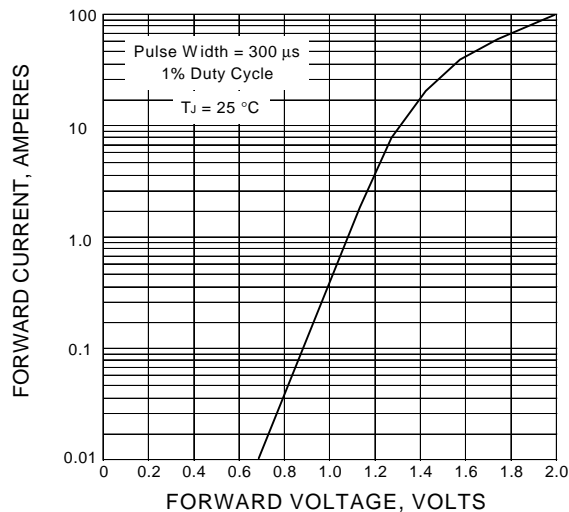
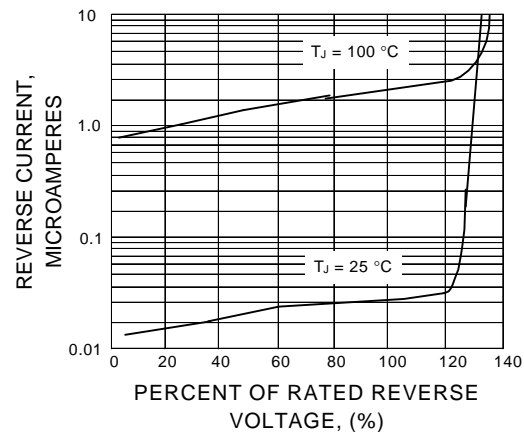


FIG.5 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER DIODE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9